

2SB1062

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

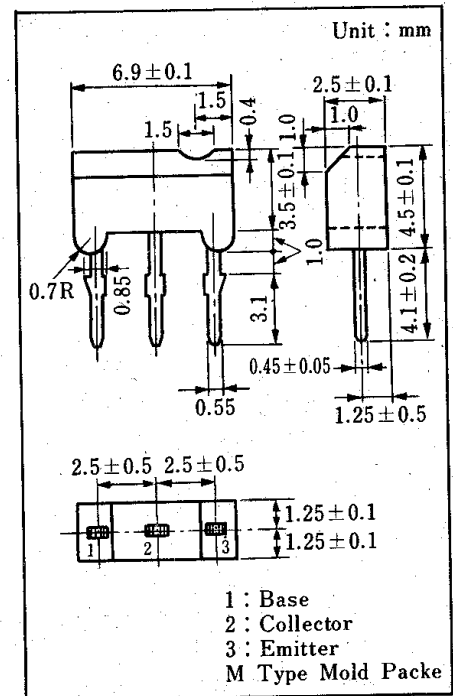
低周波出力増幅用 / AF Output Amplifier

■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$
- M 型パッケージで、自動挿入、手挿入が容易、P 板に自立固定できる。
M type package suitable for automatic insertion, easier manual insertion and self-standing on PC board.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-15	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-10	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-1.0	A
コレクタ電流	I_C	-0.5	A
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 0$			-100	nA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = -10\text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	-15			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = -1\text{ mA}, I_B = 0$	-10			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = -10\text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	-7			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*1}	$V_{CE} = -2\text{ V}, I_C = -0.5\text{ A}^{*2}$	100		350	
	h_{FE2}	$V_{CE} = -2\text{ V}, I_C = -1.0\text{ A}^{*2}$	60			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -0.4\text{ A}, I_B = -8\text{ mA}^{*2}$		-0.16	-0.2	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -0.4\text{ A}, I_B = -8\text{ mA}^{*2}$		-0.8	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 50\text{ mA}$		130		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$		22		pF

*2: パルス測定 / Pulse Test

*1: h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	Q	R	S
h_{FE1}	100 ~ 155	130 ~ 220	180 ~ 350